



Universität Stuttgart



Institut für  
Robuste  
Leistungshalbleitersysteme

# Fachpraktikum (Bachelor)

## 6G HARDWARELABOR - DESIGN UND IMPLEMENTIERUNG EINES HF TRANSCEIVERS

---

### Versuch 2: Auslegung eines HF-Verstärkers

---

**Protokollführer**

Lukas Müller

Erik Zimmermann

Farhad Valizada

**Betreuer**

Simon Haussmann

**Eingereicht**

am 20.05.2025

# Inhaltsverzeichnis

<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>1 Einleitung(Farhad)</b>	<b>4</b>
1.1 Ziel des Versuchs . . . . .	4
1.2 Relevanz und Anwendungsbereiche von HF-Verstärkern . . . . .	4
<b>2 Theoretische Grundlagen(Lukass)</b>	<b>5</b>
2.1 Funktion eines HF-Verstärkers . . . . .	5
2.2 Arbeitspunkteinstellung . . . . .	6
2.2.1 Dimensionierung des Kollektorwiderstandes . . . . .	6
2.2.2 Dimensionierung des Basis-Spannungsteilers . . . . .	7
2.3 Bedeutung der S-Parameter . . . . .	8
2.3.1 Smith-Diagramm . . . . .	9
2.4 Koppelkondensator . . . . .	9
<b>3 Hochfrequenz-Simulation(Charhad)</b>	<b>11</b>
3.1 Inbetriebnahme von Keysight Advanced Design System (ADS) . . . . .	11
3.1.1 Installation von ADS . . . . .	11
3.1.2 Erstellen eines neuen Projekts . . . . .	11
3.1.3 Vertrautmachen mit der Benutzeroberfläche . . . . .	12
3.2 Analyse des Datenblattes zum Transistor BFR181W . . . . .	12
3.3 DC-Simulation . . . . .	13
3.3.1 Dimensionierung des Kollektorwiderstandes . . . . .	13
3.3.2 Dimensionierung des Basis-Spannungsteilers . . . . .	14
3.4 S-Parameter-Simulation . . . . .	15
<b>4 Technische Umsetzung(Erik)</b>	<b>17</b>
4.1 Platinaufbau . . . . .	17
4.2 Bestückung der PCB . . . . .	18
4.3 DC-Pegel verifizieren . . . . .	19
4.4 SOLT-Kalibrierung . . . . .	19
4.5 Vergleich zur Simulation . . . . .	20
<b>5 Diskussion der Ergebnisse(GangBang)</b>	<b>21</b>
5.1 Vergleich von Theorie und Praxis . . . . .	21
5.2 Erklärung von Abweichungen . . . . .	21
<b>6 Fazit(Jeder)</b>	<b>22</b>

6.1	Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse . . . . .	22
6.2	Reflexion und mögliche Verbesserungen . . . . .	22
6.3	Eigene Reflexion . . . . .	22
6.3.1	Erik . . . . .	22
6.3.2	Farhad . . . . .	22
6.3.3	Lukas . . . . .	23
<b>Literaturverzeichnis</b>		<b>24</b>

# Abkürzungsverzeichnis

<b>ADS</b>	Advanced Design System
<b>HF</b>	Hochfrequenz
<b>6G</b>	Sixth Generation
<b>SMA</b>	SubMiniature version A
<b>PCB</b>	Printed Circuit Board

# Kapitel 1

## Einleitung(Farhad)

### 1.1 Ziel des Versuchs

Ziel des Versuchs ist es, einen HF-Verstärker zu simulieren und dessen Eigenschaften zu analysieren. Dabei wird ein BJT-Transistor verwendet, um die Verstärkung des Signals zu erhöhen. Der Versuch umfasst die Analyse der Eigenschaften des vorliegenden Transistors der Reihe BFR181W, die Berechnung der Widerstände zur Anpassung des Arbeitspunkts, um eine optimale Verstärkung zu erzielen, sowie die Durchführung einer S-Parameter-Simulation zur Überprüfung der Verstärkung und Stabilität des Verstärkers.

### 1.2 Relevanz und Anwendungsbereiche von HF-Verstärkern

Ein HF-Verstärker ist ein elektronisches Gerät, das Hochfrequenzsignale verstärkt. Diese Signale liegen typischerweise im Frequenzbereich von 3 kHz bis 300 GHz und finden Anwendung in verschiedenen Bereichen wie der Kommunikationstechnik, Radartechnologie, Satellitenkommunikation sowie in der Medizintechnik. HF-Verstärker sind entscheidend für die Signalübertragung und -verarbeitung in modernen Kommunikationssystemen. Sie werden eingesetzt, um schwache Signale zu verstärken, die von Antennen empfangen werden, und um sicherzustellen, dass die Signale über große Entfernungen übertragen werden können.

In unserem Versuch ist es von großer Bedeutung, die Eigenschaften des BJT-Transistors zu analysieren und die Widerstände so zu dimensionieren, dass ein stabiler Arbeitspunkt erreicht wird, damit bei späteren Versuchen eine Übertragung einer Bilddatei bei einer Frequenz von 1,25 GHz möglich ist.

## Kapitel 2

# Theoretische Grundlagen(Lukass)

### 2.1 Funktion eines HF-Verstärkers

Ein Verstärker ist ein elektronisches Gerät mit mindestens einem aktiven Bauelement, wie zum Beispiel einem Transistor. Das Ziel eines Verstärkers ist es, das Ausgangssignal größer als das Eingangssignal zu machen. Da hierbei dem Signal Leistung hinzugefügt wird, muss ein Verstärker eine eigene Energiequelle besitzen.

Besonders in der Hochfrequenztechnik (HF) spielt der Verstärker eine wichtige Rolle. Soll zum Beispiel mithilfe einer Antenne noch in weiter Entfernung ein Signal gemessen werden, muss dieses zuerst verstärkt werden.

Normalerweise werden im Hochfrequenzbereich Frequenzen von 10 kHz bis 100.000 MHz verstärkt.

## 2.2 Arbeitspunkteinstellung

Der Arbeitspunkt einer elektronischen Schaltung beschreibt den Ruhezustand, wenn kein Signal angelegt ist. Der Arbeitspunkt liegt mittig im linearen Bereich der Kennlinie des Transistors, sodass eine verzerrungsfreie Signalverstärkung möglich ist.

- Wäre der Arbeitspunkt zu niedrig eingestellt, würde der Transistor in den Sperrbereich geraten und das Signal würde unten abgeschnitten werden.
- Wäre der Arbeitspunkt zu hoch eingestellt, würde der Transistor in den Sättigungsbereich geraten und das Signal würde oben abgeschnitten werden.

Je nach Einstellung kann die Schaltung unterschiedlich auf das Eingangssignal reagieren. Häufig wird in der Emitterschaltung ein zusätzlicher Emitterwiderstand eingebaut, der zu einer Stromgegenkopplung führt. Dieser Widerstand sorgt dafür, dass der Arbeitspunkt stabil bleibt, auch wenn sich die Temperatur ändert. Da wir bei unserem Versuch mit konstanter Temperatur arbeiten, ist dieser nicht notwendig und wird vernachlässigt.

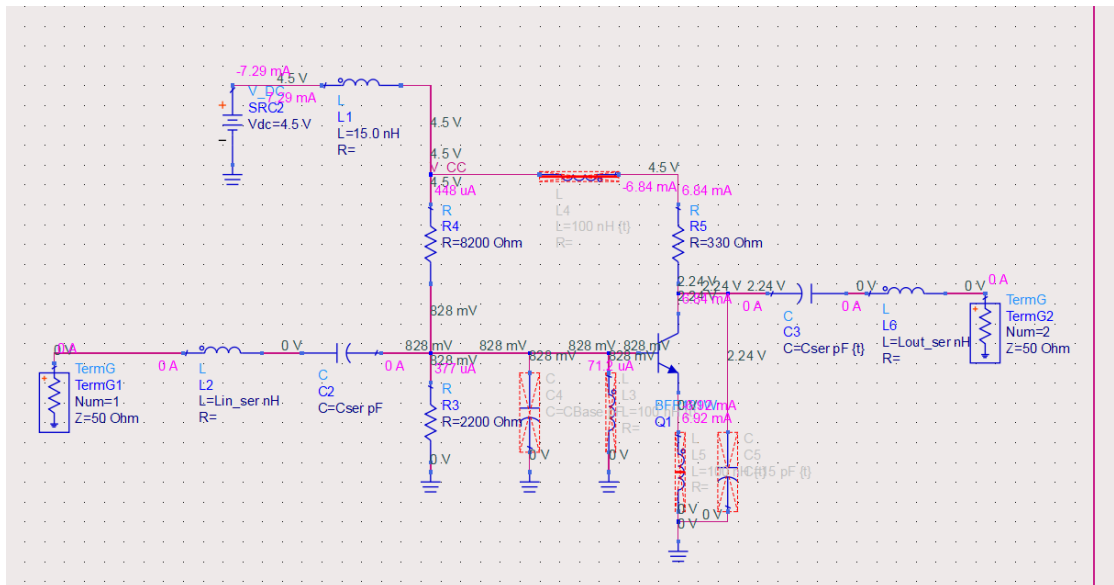


ABBILDUNG 2.1: Emitterschaltung

### 2.2.1 Dimensionierung des Kollektorwiderstandes

Folgende Spannungswerte seien gegeben:

- $U_{CC} = 4.8 \text{ V}$
- $U_{BE} = 0.77 \text{ V}$

Der Kollektorstrom  $I_C$  wird auf 75 % des maximal zulässigen Kollektorstroms  $I_{C,\max} = 20 \text{ mA}$  gesetzt. Der Widerstandswert  $R_5$  wird mit folgender Formel berechnet:

$$R_5 = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C} = \frac{4,8 \text{ V}}{15 \text{ mA}} = 320 \, \Omega \quad (2.1)$$

Bei der Verwendung der E12-Reihe wird eine Faustregel angewendet, nach der man die Widerstandswerte auf die nächstgelegene E12-Reihe aufrundet. Somit beträgt der errechnete Widerstandswert von  $R_5$   $330 \, \Omega$ . Dadurch wird der in den Kollektor eingehende Strom begrenzt, was eine Überlastung des Transistors im Dauerbetrieb verhindert. Bei der Wahl eines niedrigeren Widerstandswertes würde der Kollektorstrom  $I_C$  den maximalen Kollektorstrom  $I_{C,\max}$  überschreiten, was zu einer Überlastung des Transistors führen würde.

### 2.2.2 Dimensionierung des Basis-Spannungsteilers

Der Basisstrom berechnet sich zu:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \quad (2.2)$$

Für einen typischen Verstärkungsfaktor  $\beta = 100$  ergibt sich:

$$I_B = \frac{10 \text{ mA}}{100} = 0,1 \text{ mA} = 100 \, \mu\text{A} \quad (2.3)$$

Der Querstrom des Spannungsteilers  $I_Q$  sollte mindestens das 10-fache des Basisstroms betragen:

$$I_Q = 10 \cdot I_B = 1,0 \text{ mA} \quad (2.4)$$

Die Basisspannung  $U_B$  ergibt sich zu:

$$U_B = U_{BE} + U_E \approx 0,77 \text{ V} \quad (2.5)$$

Für die Betriebsspannung  $U_{CC} = 4,8 \text{ V}$  ergeben sich die Widerstände  $R_4$  (oben) und  $R_3$  (unten):

$$R_3 = \frac{U_B}{I_Q} = \frac{0,77 \text{ V}}{1,0 \text{ mA}} = 0,77 \text{ k}\Omega \quad (2.6)$$

$$R_4 = \frac{U_{CC} - U_B}{I_Q} = \frac{4,8 \text{ V} - 0,77 \text{ V}}{1,0 \text{ mA}} = 4,03 \text{ k}\Omega \quad (2.7)$$



Nach der Berechnung ergibt sich für  $R_3$  ein Wert von  $0,77\text{ k}\Omega$ . In der praktischen Simulation mit ADS zeigte sich jedoch, dass mit diesem Wert ein negatives Gain bei der S-Parameter-Simulation auftritt. Daher wird  $R_3$  nach der E12-Reihe auf  $1,0\text{ k}\Omega$  erhöht, um einen stabilen Arbeitspunkt und ein positives Verstärkungsverhalten zu gewährleisten.

Mit der E12-Reihe werden gewählt:

$$R_3 = 1,0\text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 4,7\text{ k}\Omega$$

Damit ist der Spannungsteiler dimensioniert, sodass sich der Arbeitspunkt im linearen Bereich des Transistors befindet.

## 2.3 Bedeutung der S-Parameter

S-Parameter bzw. Streuparameter werden genutzt, um die HF-Eigenschaften eines Netzwerks darzustellen. Sie werden benötigt, um zu verstehen, welche Anteile eines Signals reflektiert, durchgelassen oder zwischen den Ports eines Netzwerks übertragen werden. Sie werden komplex dargestellt, also mit Betrags- und Phasenkomponente.

Die Indexnummerierung folgt dem Energiefluss:

- Verläuft die Energie von Port 1 zu Port 1, heißt der S-Parameter S11.
- Verläuft die Energie von Port 2 zu Port 1, heißt der S-Parameter S21.

Somit können an einem Zweitor folgende S-Parameter auftreten:

- S11 ist der Eingangsreflexionsfaktor. Dieser Parameter gibt an, wie viel des Eingangssignals zurückreflektiert wird.
- S21 ist der Vorwärtstransmissionsfaktor. Dieser Parameter gibt die Effizienz der Signalübertragung vom Eingang zum Ausgang an.
- S12 ist der Rückwärtstransmissionsfaktor. Dieser Parameter gibt an, wie gut Port 1 von Signalen von Port 2 isoliert ist.
- S22 ist der Ausgangsreflexionsfaktor. Dieser Parameter gibt an, wie viel des Ausgangssignals zurückreflektiert wird.

### 2.3.1 Smith-Diagramm

Das Smith-Diagramm ermöglicht die grafische Darstellung der S-Parameter. Dafür werden der Real- und Imaginärteil des Reflexionsfaktors in Abhängigkeit von der Frequenz aufgetragen und ermöglichen dadurch eine einfachere Impedanzanpassung.

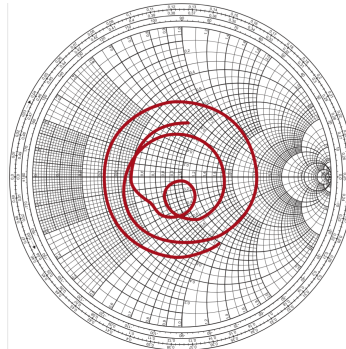


ABBILDUNG 2.2: Smith-Diagramm Beispiel

Quelle [https://www.rohde-schwarz.com/de/produkte/messtechnik/essentials-test-equipment/spectrum-analyzers/s-parameter-verstehen\\_257831.html#gallery-13](https://www.rohde-schwarz.com/de/produkte/messtechnik/essentials-test-equipment/spectrum-analyzers/s-parameter-verstehen_257831.html#gallery-13)

## 2.4 Koppelkondensator

Die seriellen Kapazitäten bzw. Koppelkondensatoren in einer Emitterschaltung haben mehrere Aufgaben. Zum einen kompensieren sie Störungen, filtern den Gleichanteil aus der Wechselspannung heraus und dienen gleichzeitig als Hochpass.

emitterwiderstand arbeitskennlinie

## Kapitel 3

# Hochfrequenz-Simulation(Charhad)

In diesem Kapitel wird die Hochfrequenz (HF)-Simulation des Transistors BFR181W durchgeführt sowie die Dimensionierung der Widerstände  $R_3$ ,  $R_4$  und  $R_5$  aus dem Kapitel 2: “Theoretische Grundlagen” überprüft und belegt.

### 3.1 Inbetriebnahme von Keysight Advanced Design System (ADS)

#### 3.1.1 Installation von ADS

Die Software Advanced Design System (ADS) dient zur Simulation von Schaltungen unterschiedlichen Komplexitätsgrades. In diesem Versuch wird die Software verwendet, um eine Hochfrequenzschaltung zu simulieren und zu analysieren. Die Software bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter die Möglichkeit, Schaltungen zu entwerfen, S-Parameter zu simulieren und verschiedene Analysewerkzeuge zu nutzen.

#### 3.1.2 Erstellen eines neuen Projekts

Die Software ist auf den Rechnern im ILH-Labor bereits installiert.

Nach dem Start der Software wird ein neues Projekt aus den bereits zur Verfügung stehenden Workspaces erstellt.

Diese sind auf der ILIAS-Seite des Praktikums im Dateiarchiv `TransmitterAmpDesign2024.zip` hinterlegt.

Die Datei wird entpackt und in der Software geöffnet. Außerdem werden die benötigten Bibliotheken aus dem Dateiarhiv **Infineon-RFTransistor-Keysight ADS Design Kit-SM-v02 10-EN.zip** geladen. Diese stehen ebenfalls auf der ILIAS-Seite zur Verfügung.

### 3.1.3 Vertrautmachen mit der Benutzeroberfläche

Schließlich werden die Tutorials 1 und 2 von **ADS** durchgearbeitet, um sich mit der Benutzeroberfläche und den grundlegenden Funktionen der Software vertraut zu machen. Zu Beginn der Schaltungsanalyse wird das Schema **TX\_Amp\_Bias.dds** geöffnet. Dieses ist in Abbildung 3.1 zu sehen.

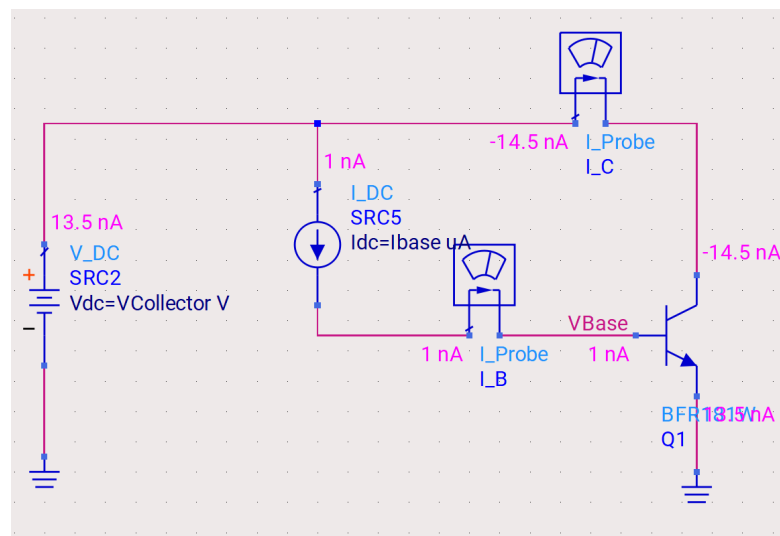


ABBILDUNG 3.1: Schaltbild der Schaltung **TX\_Amp\_Bias.dds** in **ADS**.

## 3.2 Analyse des Datenblattes zum Transistor BFR181W

Um die Schaltung zu simulieren, wird der Transistor BFR181W aus der verfügbaren Bibliothek verwendet. Die genauen Parameter des Transistors werden aus dem Datenblatt entnommen. Dieses steht ebenfalls auf der ILIAS-Seite des Praktikums zur Verfügung.

Die Tabelle “Maximum Ratings at  $T_A = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified” unten links auf Seite 1 des Dokuments zeigt, dass der maximal zulässige Kollektorstrom  $I_{C,\text{max}}$  20 mA beträgt.

### 3.3 DC-Simulation

Im Folgenden wird eine DC-Simulation der später aufzubauenden Schaltung durchgeführt. Außerdem werden die Arbeitspunkte optimal durch die Anpassung der Widerstandswerte eingestellt. Die DC-Simulation wird in ADS durchgeführt, um die DC-Pegel der Schaltung zu überprüfen.

#### 3.3.1 Dimensionierung des Kollektorwiderstandes

Das errechnete Ergebnis aus dem Kapitel 2.2.1 lässt sich anhand der Simulation verifizieren.

Zuerst wird ein Sweep des Kollektorwiderstandes  $R_5$  im Bereich von  $100\ \Omega$  bis  $4,7\ \text{k}\Omega$  durchgeführt. Es ergibt sich folgender Verlauf des Kollektorstroms  $I_C$  in Abhängigkeit des Kollektorwiderstandes  $R_5$ :

Einstellung Arbeitspunkt

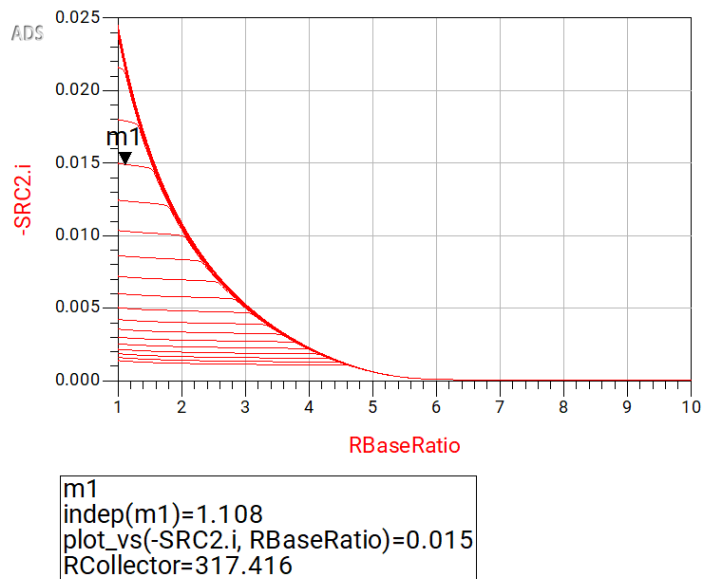


ABBILDUNG 3.2: Verlauf des Kollektorstroms  $I_C$  in Abhängigkeit des Kollektorwiderstandes  $R_5$ .

Aus Abbildung 3.2 ist zu erkennen, dass der Kollektorstrom  $I_C$  mit steigendem Kollektorwiderstand  $R_5$  abnimmt. Mit dem Marker m1 wird außerdem gezeigt, dass der Kollektorstrom  $I_C$  bei einem Widerstandswert von  $317,416\ \Omega$  einen Wert von  $15\ \text{mA}$  erreicht.

Es wird der nächstgrößere Widerstandswert der E12-Reihe gewählt, also  $330\Omega$ , damit  $I_C$  nicht überschritten wird. Die Ergebnisse der Rechnung werden somit bestätigt.

### 3.3.2 Dimensionierung des Basis-Spannungsteilers

Um einen Arbeitspunkt mit  $I_C \approx 10\text{ mA}$  zu erreichen, wird der Basis-Spannungsteiler dimensioniert. Die Basis-Emitter-Spannung beträgt  $U_{BE} \approx 0,7\text{ V}$ .

Auch hier kann die im Kapitel 2.2.2 berechnete Dimensionierung überprüft werden. Beim Sweepen des Widerstandes  $R_3$  im Bereich von  $100\Omega$  bis  $4,7\text{ k}\Omega$  und des damit verbundenen Spannungsteilers, also auch durch das Sweepen des Widerstandes  $R_4$ , ergibt sich folgender Verlauf des Basisstroms  $I_B$  in Abhängigkeit des Widerstandes  $R_3$ :

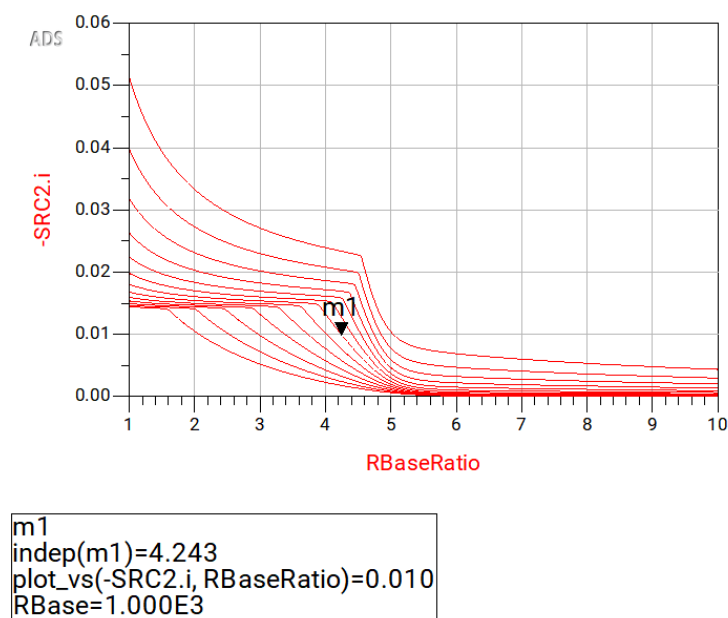



ABBILDUNG 3.3: Verlauf des Basisstroms  $I_B$  in Abhängigkeit des Basiswiderstandes  $R_3$ .

Abbildung 3.3 bestätigt, dass der Basiswiderstand  $R_3$  mit einem Wert von  $1,0\text{ k}\Omega$  einen Kollektorstrom  $I_C$  von  $10\text{ mA}$  ergibt. Hierbei ist auch zu erkennen, dass sich ein  $R_B$ -Ratio von  $4,243$  ergibt. Das bedeutet, dass der Widerstand  $R_4$  einen Widerstandswert von  $4,243\text{ k}\Omega$  haben sollte. Bei der Anpassung an die E12-Reihe wird der Widerstandswert auf  $4,7\text{ k}\Omega$  gewählt. Dies erfüllt die errechneten Bedingungen für die Widerstandswerte und bestätigt die ausgewählte Dimensionierung.

### 3.4 S-Parameter-Simulation

Schließlich wird die S-Parameter-Simulation durchgeführt. Diese ist wichtig, um einen angemessenen Gain bei der Übertragung zu gewährleisten. Die S-Parameter-Simulation wird in ADS nach folgenden Schritten durchgeführt:

1. Im ADS-Model wird die Kommentierung des S-Parameter-Controllers aufgehoben, also die S-Parameter-Einstellung wird aktiviert.
2. Da jetzt die DC-Simulation überflüssig ist, wird diese deaktiviert.
3. Vor der Simulation wird die Schrittweite des S-Parameter-Controllers auf 250 MHz gesetzt, sodass die Qualität des Frequenz-Sweeps verbessert wird. 
4. Nach der Simulation wird das Ergebnis in einem neuen Fenster angezeigt. Es ergibt sich folgender Verlauf des Gains für verschiedene Frequenzen:

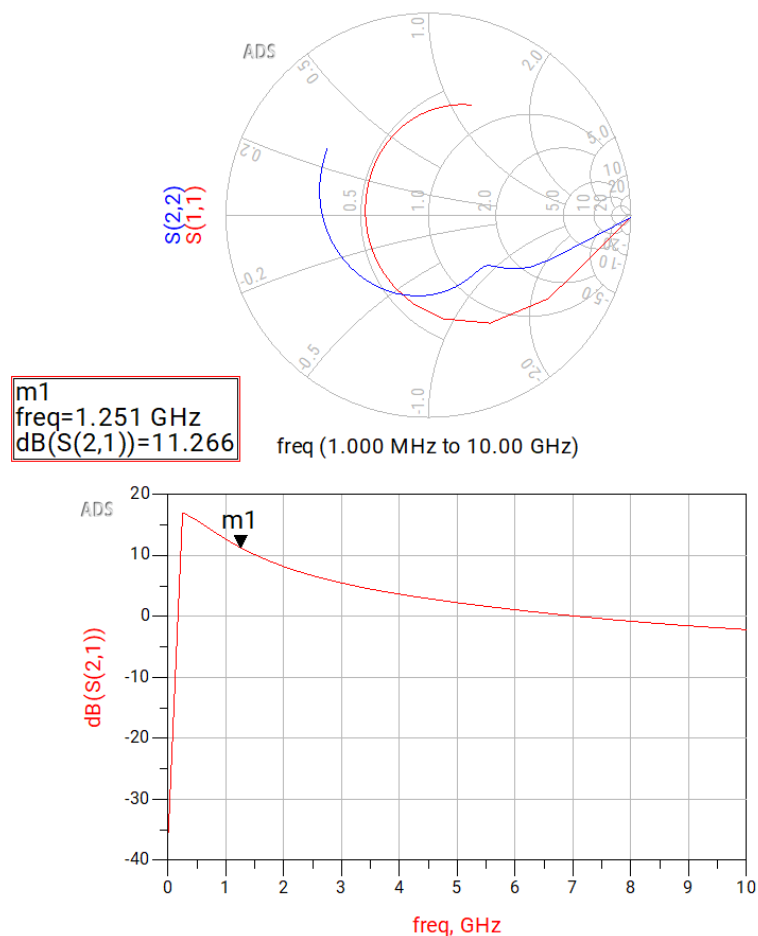



ABBILDUNG 3.4: Ergebnisse der S-Parameter-Simulation.



Hier wählt man die Schaltfläche “Insert A New Marker” aus . Wir setzen den Marker auf den Punkt unserer Arbeitsfrequenz, also bei 1,25 GHz (siehe Abbildung 3.4). Der Marker m1 zeigt eine **Verstärkung (Gain) von 11,266 dB** an.

Die Ergebnisse der Simulation werden bei der technischen Umsetzung der Schaltung überprüft.

# Kapitel 4

## Technische Umsetzung(Erik)

### 4.1 Platinenaufbau

Die Platine ist mit mehreren Bauteilen ausgestattet, die bis auf drei selbst zu dimensionierende Widerstände bereits vollständig bestückt ist.

Zur Erklärung von Abbildung 4.1 hier eine kurze Information zu den wichtigsten Abkürzungen:

- R: Widerstand
- C: Kondensator
- J: Stecker/Relais

Die wichtigsten Bauteile sind:

- J1: Anschluss an den FieldFox (Ausgangssignal)
- J40: Verbindung zum Oszillator (Taktquelle für die Schaltung) und Anschluss an den FieldFox (Eingangssignal)
- R47-49: Widerstände zur Arbeitspunkteinstellung
- Oszillator (XLL536C50.000000X): HF-Taktsignal
- Transistor (BFR181W)
- Operationsverstärker (U20-LMV651MG/NOPB; U21-NCX2200GW,125)
- USB-UART-IC (FT232RL)

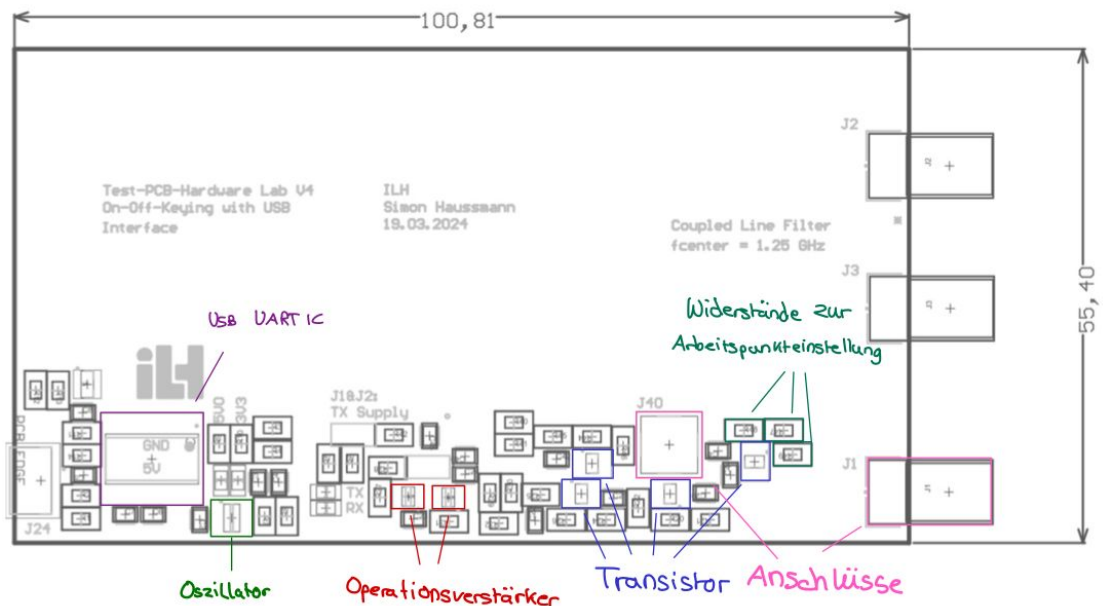


ABBILDUNG 4.1: Bestückungsplan

## 4.2 Bestückung der PCB

Die in Kapitel 3 bestimmten Widerstände werden nun im Rahmen der praktischen Umsetzung der Schaltung auf die bereits vorbereitete Platine angebracht. Auf dem Bestückungsplan entspricht R47 dem Widerstand R3 mit 1000 Ohm, R48 dem Widerstand R4 mit 4700 Ohm und R49 dem Widerstand R5 mit 330 Ohm. Beim Löten der drei Widerstände wird auf eine saubere und präzise Löttechnik geachtet, um die gewünschte elektrische, mechanische und HF-technische Funktion der Schaltung zu garantieren.

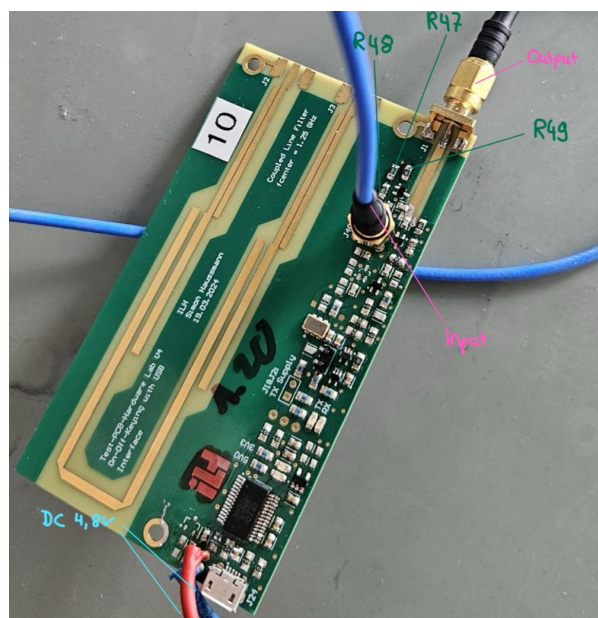


ABBILDUNG 4.2: Bestückte Platine

### 4.3 DC-Pegel verifizieren

Nach dem Bestücken der Platine wird die Funktionalität der Schaltung überprüft. Hierzu wird eine Versorgungsspannung von 4,8 V angelegt, um die Gleichspannungspegel an den relevanten Punkten der Schaltung zu überprüfen. Die abfallenden Spannungen werden mit einem Oszilloskop gemessen. Relevant sind die Spannungsabfälle über R47, R48 und R49. Diese gemessenen Spannungen werden mit den idealen Werten der Simulation verglichen.

### 4.4 SOLT-Kalibrierung

Das Ziel der SOLT-Kalibrierung (Short, Open, Load, Through) ist die Eliminierung von systematischen Messfehlern, die durch die Messeinrichtung (Kabel, Adapter etc.) selbst entstehen und die Messung verfälschen. Durch das Messen dieser Fehler lässt sich die Messung korrigieren. Dafür werden vier verschiedene Kalibrierstandards benötigt:

- Short (Kurzschluss): Ein Kurzschluss-Standard wird an den Messport des VNAs angeschlossen. Da ein idealer Kurzschluss alle Leistung reflektiert und eine Phasenverschiebung von 180 Grad verursacht, misst der VNA diese Referenz. Abweichungen vom Ideal werden erfasst.
- Open (Leerlauf): Ein Leerlauf-Standard wird angeschlossen. Ein idealer Leerlauf reflektiert ebenfalls die gesamte Leistung, jedoch mit einer Phasenverschiebung von 0 Grad. Auch hier werden Abweichungen aufgezeichnet.
- Load (Abschluss/Last): Ein Präzisions-Abschlusswiderstand (meist 50 Ohm) wird angeschlossen. Ein idealer Abschlusswiderstand absorbiert die gesamte Leistung ohne Reflexion. Dies dient dazu, die Leistungsanpassung des Systems zu kalibrieren.
- Through (Durchgang): Bei einer 2-Port-Messung wird ein direkter Durchgang (ein kurzes, bekanntes Kabel oder ein Adapter) zwischen den beiden Messports des VNAs angeschlossen. Dies ermöglicht die Kalibrierung der Übertragungseigenschaften zwischen den Ports und die Korrektur von Phasen- und Amplitudenfehlern des Übertragungspfades.

Die Kalibrierung wird am Keysight FieldFox durchgeführt. Sie erfolgt über sieben Schritte, die vom Gerät angeleitet werden. Danach ist das Gerät bereit für die Messung.



ABBILDUNG 4.3: Kalibrierung am Keysight FieldFox

## 4.5 Vergleich zur Simulation

Die Simulation wurde, wie zuvor beschrieben, mit der Software Advanced Design System (ADS) durchgeführt. In der Simulation fällt über R47 eine Spannung von 0,811 V, über R48 eine Spannung von 3,989 V und über R49 eine Spannung von 1,27 V ab. Wir überprüfen nun, ob sich unsere Messung mit den simulierten Werten deckt.

Widerstand	Simulation [V]	Messung [V]
R47	0,811	0,809
R48	3,989	3,991
R49	1,27	1,26

TABELLE 4.1: Vergleich von simulierten und gemessenen Spannungswerten

## Kapitel 5

# Diskussion der Ergebnisse(GangBang)

### 5.1 Vergleich von Theorie und Praxis

### 5.2 Erklärung von Abweichungen

bla bla

# Kapitel 6

## Fazit(Jeder)

### 6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

### 6.2 Reflexion und mögliche Verbesserungen

### 6.3 Eigene Reflexion

#### 6.3.1 Erik

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Simulation des HF-Verstärkers erfolgreich war. Die Aufgaben wurden sinnvoll bearbeitet und stimmen mit der Theorie überein. Der Versuch hat das Verständnis für das in den Vorlesungen bereits angeschnittene theoretische und praktische Wissen erweitert und weiter vertieft und macht Lust auf mehr.

#### 6.3.2 Farhad

Zusammenfassend zur HF-Simulation lässt sich sagen, dass die Simulation der Hochfrequenzschaltung mit [ADS](#) erfolgreich durchgeführt wurde. Die Dimensionierung der Widerstände wurde erfolgreich vorgenommen, um einen stabilen Arbeitspunkt zu erreichen. Auch die S-Parameter-Simulation zeigte ein positives Gain von 11,266 dB bei einer Frequenz von 1,25 GHz. Die Ergebnisse der Simulation stimmen mit den theoretischen Berechnungen überein. Die Software [ADS](#) erwies sich als nützliches Werkzeug zur Analyse und Simulation von Hochfrequenzschaltungen.

### 6.3.3 Lukas

Der Versuch hat mir zum ersten Mal anschaulich gezeigt, wie ein Verstärker in der Praxis tatsächlich funktioniert. In zahlreichen Vorlesungen haben wir zwar bereits die Arbeitspunkteinstellung und die Dimensionierung von Widerständen theoretisch durchgerechnet, jedoch fehlte bisher der praktische Bezug. Es war daher sehr interessant zu sehen, wie diese Konzepte im realen Aufbau umgesetzt werden und welche Herausforderungen dabei auftreten.

Besonders spannend fand ich die Aufgabe, die Widerstände so zu dimensionieren, dass ein stabiler Arbeitspunkt erreicht wird. Dabei habe ich festgestellt, dass dies in der Praxis deutlich anspruchsvoller ist als in der Theorie, da die Bauteile nicht beliebig gewählt werden können, sondern auf die Werte der E12-Reihe beschränkt sind. Dies erfordert zusätzliche Überlegungen und Anpassungen, um die gewünschten Schaltungseigenschaften zu realisieren.



# Literaturverzeichnis

- [1] Infineon Technologies AG: *BFR181W Silicon NPN RF Transistor*, Datenblatt, 2017. Online verfügbar unter: [https://ilias3.uni-stuttgart.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=z5:o1&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref\\_id=4067156](https://ilias3.uni-stuttgart.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=z5:o1&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref_id=4067156) (zugegriffen am 19.05.2025)
- [2] Advanced Test Equipment Corp.: *What is an RF Amplifier?*, o.J.. Online verfügbar unter: <https://www.atecorp.com/solutions/what-is-an-rf-amplifier> (zugegriffen am 17.05.2025)
- [3] Wikipedia: *Verstärker (Elektrotechnik)*, o.J.. Online verfügbar unter: [https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rker\\_\(Elektrotechnik\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4rker_(Elektrotechnik)) (zugegriffen am 17.05.2025)
- [4] Denisowski, Paul: *S-Parameter verstehen*. In: Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG, o.J.. Online verfügbar unter: [https://www.rohde-schwarz.com/de/produkte/messtechnik/essentials-test-equipment/spectrum-analyzers/s-parameter-verstehen\\_257831.html#gallery-7](https://www.rohde-schwarz.com/de/produkte/messtechnik/essentials-test-equipment/spectrum-analyzers/s-parameter-verstehen_257831.html#gallery-7) (zugegriffen am 18.05.2025)
- [5] Simon Haussmann: *Schaltplan\_PCB\_V4*, 15. April 2024. In: Institut für Robuste Leistungshalbleitersysteme, Universität Stuttgart. Online verfügbar unter: [https://ilias3.uni-stuttgart.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=z5:o1&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref\\_id=4067155](https://ilias3.uni-stuttgart.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=z5:o1&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref_id=4067155) (zugegriffen am 19.05.2025)